

(N) interface monolithic integrated circuits, multichip integrated circuits, film-type integrated circuits or hybrid integrated circuits, that are:

(I) line drivers and line receivers that have a typical propagation delay time from data input to output or, where the propagation delay time is not specified, the lesser of the typical turn-on and turn-off time, of not less than 15 ns,

(II) peripheral or display drivers that have

1. a maximum rated output current of 500 mA or less,
2. a typical propagation delay time from data input to output or, where the typical propagation delay time is not specified, the lesser of the typical turn-on and turn-off time, of not less than 20 ns, and

3. a maximum rated output voltage of 80 V or less,

(III) sense amplifiers that have

1. a typical propagation delay time from data input to output or, where the typical propagation delay time is not specified, the lesser of the typical turn-on and turn-off time, of not less than 15 ns, and

2. a typical input threshold voltage of not less than 10 mV, or

(IV) storage or clock drivers that have

1. a maximum rated output current of 500 mA or less,
2. a maximum rated output voltage of 30 V or less, and
3. a typical propagation delay time from data input to output or, where the typical propagation delay time is not specified, the lesser of the typical turn-on and turn-off time, of not less than 20 ns,

(O) peripheral PMOS or NMOS monolithic integrated circuits or multichip integrated circuits that are designed only for

(I) the support of microprocessor microcircuits that are expressly excluded by clause (I), and

(II) PIO, SIO, DART or CTC functions,

(P) sample and hold monolithic integrated circuits, multichip integrated circuits, film-type integrated circuits or hybrid integrated circuits that have

(I) an acquisition time of not less than 10  $\mu$ s, and

(II) a non-linearity of equal to or greater than  $\pm 0.01$  per cent of full scale for a hold time of 1  $\mu$ s,

(N) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à microplaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides d'interface, à savoir:

(I) transmetteurs de ligne et récepteurs de ligne qui ont un retard de propagation typique de l'entrée des données à la sortie des données d'au moins 15 ns ou, lorsque le retard de propagation typique n'est pas spécifié, dont le moindre du temps de passage typique à l'état conducteur et du temps de passage typique à l'état bloqué est d'au moins 15 ns,

(II) commandes de périphériques ou de visuels qui ont à la fois:

1. un courant de sortie nominal maximal d'au plus 500 mA,

2. un retard de propagation typique, de l'entrée à la sortie des données, d'au moins 20 ns ou, lorsque le retard de propagation typique n'est pas spécifié, dont le moindre du temps de passage typique à l'état conducteur ou du temps de passage typique à l'état bloqué est d'au moins 20 ns,

3. une tension de sortie nominale maximale d'au plus 80 V,

(III) amplificateurs à grand gain qui ont à la fois:

1. un retard de propagation typique, de l'entrée à la sortie des données, d'au moins 15 ns ou, lorsque le retard de propagation typique n'est pas spécifié, dont le moindre du temps de passage typique à l'état conducteur ou du temps de passage typique à l'état bloqué est d'au moins 15 ns,

2. une tension de seuil d'entrée typique d'au moins 10 mV,

(IV) commandes de mémoire et de signal d'horloge qui ont à la fois:

1. un courant de sortie nominal maximal d'au plus 500 mA,

2. une tension de sortie nominale maximale d'au plus 30 V,

3. un retard de propagation typique, de l'entrée à la sortie des données, d'au moins 20 ns ou, lorsque le retard de propagation typique n'est pas spécifié, dont le moindre du temps de passage typique à l'état conducteur ou du temps de passage typique à l'état bloqué est d'au moins 20 ns,

(O) circuits intégrés monolithiques ou circuits intégrés à microplaquettes multiples périphériques PMOS ou NMOS qui sont conçus uniquement pour:

(I) le soutien de microcircuits microprocesseurs exclus par la division (I),

(II) une fonction de ESP, ESS, ERAD ou de circuit compteur et rythmeur,

(P) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à microplaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides échantillonneurs-bloqueurs qui ont, à la fois:

(I) un temps d'acquisition d'au moins 10  $\mu$ s,

(II) une non-linéarité égale ou moins précise que  $\pm 0,01$  pour cent pour la pleine échelle pour un temps de blocage de 1  $\mu$ s,